# 走査トンネル顕微鏡で探るナノカーボンの微視的な光電子物性 片野 諭<sup>11</sup>

Microscopic Photo-electronic Properties of Nano Carbons Investigated by Scanning Tunneling Microscopy Satoshi KATANO<sup>1\*</sup>

### 1. はじめに

カーボンナノチューブ (CNT) やグラフェンなど のナノカーボンは、従来のシリコン半導体や化合物半 導体とは異なるユニークな電気伝導性や光学特性を示 すため、次世代の電子素子材料として期待されてい る<sup>1)</sup>。グラフェンは、炭素原子同士がハニカム格子構 造で sp<sup>2</sup> 結合した平面シート状物質である。このグラ フェンシートを円筒状に巻くと CNT となる。CNT は、 その巻き方により金属型あるいは半導体型の電子構造 となる。これらナノカーボンの電子準位は、基本的に は炭素骨格の構造によって決定される。一方、ナノカー ボンの炭素原子を他の原子や分子で置換するとナノ カーボンの光電子特性が大きく変化するといった報告 が近年多数報告されている<sup>2,3)</sup>。例えば、CNT を酸化 したり、分子を接続すると、CNT の発光強度や発光 波長が変化する<sup>2)</sup>。また、グラフェンを酸化すると酸 化グラフェン(GO)ができるが、このGOの酸化状 態によって、電気伝導度や発光エネルギーが大きく変 化する<sup>3)</sup>。微視的な構造や化学状態がナノカーボンの光 電子物性に大きな影響を与えるはずであるが、光や電 気を使った従来の計測では、空間分解能の制限などに よってそれらの詳細を検討することが困難となっている。

このようなナノカーボンの局所観察に適したツール として走査トンネル顕微鏡(STM)が挙げられる<sup>4,5)</sup>。 STM により原子レベルの空間分解能で表面構造を計 測できる。また、探針 - 試料間の電圧を掃引する走査 トンネル分光(STS)により、探針直下の状態密度に 対応する電子状態計測が可能である。さらに STM 探

<sup>1</sup> 東洋大学 理工学部 応用化学科 Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Engineering, Toyo University. 針からトンネル電子を注入することにより、個々の原 子、分子、ナノ構造の電子状態を励起することができ る<sup>6)</sup>。このような励起状態からの緩和過程で、余剰な エネルギーの一部が発光として観測される。この発光 はSTM 発光と呼ばれ、STM 発光を分光することに より、単一分子やナノ構造の光電子物性を高い空間分 解能で明らかにすることができる<sup>7-13)</sup>。本稿では、 STM を用いて、ナノカーボン材料の光電子物性を微 視的に明らかにした結果について著者の事例を交えて 概説する<sup>10-13)</sup>。

### 2. 実験方法

実験は、真空度が4×10<sup>-8</sup> Paの超高真空(UHV) 装置内に設置された STM を用いて行った。実験で用 いた UHV 装置の概略を図1に示す。Au(111)単結晶 基板、もしくはマイカ上に 膜厚 200 nm 程度の Au(111)単結晶薄膜を形成させた基板を金属試料基板



\* Corresponding Author : katano029@toyo.jp



図 2:電解研磨で作製した STM 探針の SEM 像(加速 電圧 =10 kV)。(a) は探針の全体、(b) は探針の先端部分。



図 3: Au(111) 上に固定した多層 CNT の STM 像(計 測条件:バイアス電圧 =1.5 V、トンネル電流 =1.0 nA)。Reproduced from Ref. 11 with the permission of AIP Publishing.

とした。UHV 装置内に設置されたイオンガンと加熱 ステージを用いて、Ar<sup>+</sup>イオンスパッタリングとア ニーリング処理を行い金属基板の清浄化を行った。こ の清浄化は、STMもしくは低速電子線回折(LEED) で基板の清浄度が確認されるまで繰り返し行った。清 浄化された Au(111) 基板上に CNT、もしくはオクタ ンチオールの自己組織化単分子(C<sub>s</sub>S-SAM) 膜を成 膜した Au(111) 上に GO を固定化した。ここでは、高 い清浄性を保った状態で試料を真空中で固定化できる 乾式接触法(DCT)法を用いた<sup>11)</sup>。次に STM 関連の 計測について述べる。NaOH 水溶液中で電解研磨によ り得られた直径 0.4 mm の W 探針を使って STM 測定 を行った。作製した W 探針の全体と探針先端を拡大 した走査電子顕微鏡 (SEM) 像を図2(a) と2(b) に示す。先端の曲率半径は10nm程度となっているが、 実際には SEM の解像度を超えた原子レベルで鋭利な 先端構造となっている。探針 - 試料間に電圧を印加す ることで誘起される微弱光を、UHV 装置内に設置し たレンズで平行化した。その後、レンズと光ファイバー を通して光を分光器に取り込み、分光された光を液体 窒素で冷却された電荷結合素子で計測した<sup>4)</sup>。



図 4: (a) and (b) STM 探針を用いた CNT の局所加 工。(a) 加工前、(b) 加工後の STM 像。(c) and (d) Au(111) 上に固定した CNT の STM 発光スペクトル。 (c) defect、(d) intact の位置で得た。Reproduced from Ref. 11 with the permission of AIP Publishing.

### 結果および考察

# 3.1 カーボンナノチューブの局所加工と微細構造に起因した発光スペクトル

DCT 法により多層 CNT を固定化した Au(111) 基 板の STM 像を図3に示す<sup>11)</sup>。孤立した一本鎖の CNT が分散吸着しており、また、ステップやテラスなど基 板表面の単結晶構造が明瞭に観察されている。CNT 直上に STM の探針を固定して3V 程度の電圧パルス を印加すると(図4(a))、探針直下に盛り上がった 欠陥構造が形成された(図4(b))。CNT の微視的な 構造に依存した光物性を調べるために STM 発光計測 を行った<sup>11)</sup>。CNT の円筒構造が保たれた位置で得ら れた発光スペクトル(図4(d))はスパイク状のピー ク構造で構成されているが、これは CNT のバンド間 遷移発光に由来する。一方、新たに形成されたナノ構 造上では、円筒状の CNT と比較して発光スペクトル 大きく変化していることがわかる(図4(c))。CNT の発光は、van Hove 特異点の準位にある電子とホール



図 5:(a) GO の構造。(b) C<sub>8</sub> S-SAM 上に吸着した GO の STM 像(計測条件:バイアス電圧 =1.0 V、トンネル電流 =0.2 nA)。(c) 拡大した STM 像(2.5 nm×2.5 nm)。ハニカム構造の sp<sup>2</sup> ドメイン(破線内)が観察される。(d) GO 上の異なる位置(A~D)で得た STS スペクトル。 Reproduced from Ref. 13 with the permission of Royal Society of Chemistry.

の再結合に起因するが、ここでは欠陥構造の導入により 発光に至る緩和過程が局所的に変調されたと考えられる。

### 3.2 GO の微細構造とナノスケール電子構造

GO は、グラフェンに水酸基、カルボキシル基、エ ポキシ基などの酸素官能基が接続された炭素化合物で ある (図5 (a))<sup>12)</sup>。GO の光電子物性は、グラフェン の $\pi$ 共役が保たれた導電性の sp<sup>2</sup> ドメインと、酸素官 能基の修飾により形成された絶縁性の sp<sup>3</sup> ドメインに よって支配される。

GO を C<sub>8</sub>S-SAM/Au(111) 上に吸着させた表面の STM 像を図5 (b) に示す<sup>13)</sup>。像の下側に C<sub>8</sub>S-SAM の吸着した Au(111) 表面のテラスと単原子ステップが 観察されている。一方、像の中部から上側にかけて、 平坦性の失われた GO シートが観察されている。GO の高さは 0.6~1.1 nm の範囲であり、単層グラフェ ンよりも高い。これは、酸素官能基が接続されて sp<sup>3</sup> ドメインが形成されるとグラフェンの平面構造を保つ ことができなることに起因する。GO の原子スケール 構造を STM 観察すると、炭素原子のハニカム構造が 保存された直径 2 nm 弱の sp<sup>2</sup> ドメインを観察するこ とができる (図5 (c))<sup>13)</sup>。

C<sub>8</sub>S-SAM と GO の直上に STM 探針を固定して得 た STS スペクトルを図5(d)に示す<sup>13)</sup>。C<sub>8</sub>S-SAM 上 では、分子膜自体が絶縁性であるためフェルミエネル ギー近傍に状態密度を有さない。一方、GO 上では、 エネルギーギャップで分離された sp<sup>2</sup>ドメイン由来の  $\pi$ 、 $\pi^*$ ピークが明瞭に観察されている。測定位置を変 えて STS 計測を行うと、エネルギーギャップの大き さや、ギャップの中心エネルギーが異なることがわか る。これは、sp<sup>2</sup>ドメインの大きさや、酸素官能基からの 電子ドーピングの違いを反映していると考えられる。こ のような局在した sp<sup>2</sup>ドメインにおいて電子励起発光が 誘起されることが STM 発光計測により見出されている。

## 4. まとめ

本解説では、ナノカーボン材料の微視的光電子物性 を STM によって明らかにした結果について紹介した。 CNT の発光を原子スケールで評価できること、さら に STM 探針を用いたナノケミストリーによりその発 光を微視的に変調できることを示した。また、GO の 局所的な電子・光物性が、π共役の保存された直径わ ずか数 nm の sp<sup>2</sup>ドメインに依存することを示した。 STM を用いたマルチスペクトロスコピーを駆使する ことで電気的・光学的に活性なナノドメインを同定す ることが可能となり、その結果、高効率・高機能性な 新材料の研究開発が加速されると期待している。

#### 参考文献

- 1) A.K. Geim and K.S. Novoselov : Nat. Mater. 6 (2007) 183.
- Y. Miyauchi, M. Iwamura, S. Mouri, T. Kawazoe, M. Ohtsu and K. Matsuda : Nat. Photonics. 7 (2013) 715.
- C.-T. Chien, S.-S. Li, W.-J. Lai, Y.-C. Yeh, H.-A. Chen, I.S. Chen, L.-C. Chen, K.-H. Chen, T. Nemoto, S. Isoda, M. Chen, T. Fujita, G. Eda, H. Yamaguchi, M. Chhowalla and C.-W. Chen : Angew. Chem. Int. Ed. 51 (2012) 6662.
- 4) 片野諭、上原洋一:応用物理.80 (2011) 960.
- S. Katano, Y. Kim, H. Matsubara, T. Kitagawa and M. Kawai : J. Am. Chem. Soc. 129 (2007) 2511.
- S. Katano, Y. Kim, M. Hori, M. Trenary and M. Kawai : Science. 316 (2007) 1883.
- S. Katano, S. Ushioda and Y. Uehara : J. Phys. Chem. Lett. 1 (2010) 2763.
- S. Katano, K. Toma, M. Toma, K. Tamada and Y. Uehara : Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (2010) 14749.
- S. Katano, M. Hotsuki and Y. Uehara : J. Phys. Chem. C. 120 (2016) 28575.
- S. Katano, H. Fujita, T. Wei and Y. Uehara : J. Vac. Soc. Jpn. 59 (2016) 92.
- S. Katano, H. Fujita and Y. Uehara : Appl. Phys. Lett. 112 (2018) 011601\_1.
- 12) S. Katano, T. Wei, T. Sasajima and Y. Uehara : J. Vac. Soc. Jpn. 60 (2017) 495.
- S. Katano, T. Wei, T. Sasajima, R. Kasama and Y. Uehara : Phys. Chem. Chem. Phys. 20 (2018) 17977.